

B2S10

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number: JP60143633
Publication date: 1985-07-29
Inventor(s): HONMA YOSHIO; others: 02
Applicant(s): HITACHI SEISAKUSHO KK
Requested Patent: ☐ JP60143633
Application Number: JP19840250543 19841129
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L21/302
EC Classification:
Equivalents: JP1441504C, JP61004179B

Abstract

PURPOSE: To enable to perform a dry etching on silicon or silicon compounds sticking on the surface of a semiconductor substrate while preventing a hindrance due to carbons to the dry etching by a method wherein a plasma etching or a sputter etching is performed on the surface thereof using fluorine-containing hydrocarbon having the carbons as etching gas.

CONSTITUTION: When fluorine-containing hydrocarbon is used as etching gas, C ions and radicals generate, but H ions and radicals are also produced simultaneously and both are easily polymerized by the energy of plasma. For example, the two are polymerized into a compound in the form of $-(CH_2)-$ and the compound adheres on a material to be etched or the sidewall surface of a reaction vessel or is exhausted to the exterior. Fluorine-containing hydrocarbon having a small number of Cs is desirable as etching gas, because the less the number of Cs is, the less the hindrance due to the Cs to a dry etching is. In particular, fluorine-containing hydrocarbon having the number of Cs of less than two is desirable as etching gas. When gas containing at least one selected from among methyl fluoride, fluoroform, trifluoroethylen, vinyl fluoride, ethyl fluoride or diofluoroethane is used as etching gas, a more favorable result is obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-143633

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和60年(1985)7月29日

H 01 L 21/302

F-8223-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 半導体装置の製造方法

⑯ 特 願 昭59-250543

⑰ 出 願 昭51(1976)4月28日

⑱ 特 願 昭51-47714の分割

⑲ 発 明 者 本 間 喜 夫 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑲ 発 明 者 野 沢 悠 夫 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑲ 発 明 者 原 田 征 喜 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
 ⑲ 代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 細 書

発明の名称 半導体装置の製造方法

特許請求の範囲

フッ化メチル、フルオロホルム、トリフルオロエチレン、フッ化ビニル、フッ化エチルもしくはジフルオロエタンから選ばれた少なくとも一者を含むガスを用いて半導体基板表面のシリコンもしくはシリコン化合物をプラズマエッチングもしくはスパッタエッチングすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造方法に関し、詳しくは半導体基板表面のシリコンもしくはシリコン化合物を、炭素による障害を防止しつつドライエッチングすることのできる半導体装置の製造方法に関する。

〔発明の背景〕

周知のように、半導体装置の製造方法に用いられる食刻方法として、プラズマエッチングや高周

波スパッタエッチングが行なわれるようになった。

プラズマエッチングは、CF₄、CCl₄、酸素などのガスを数10⁻⁴~0.01 Torrの圧力下で反応室内においてプラズマ化し、このプラズマと半導体基板を接触させて、プラズマ化したガスとの反応によってエッチングするものである。

また、スパッタエッチングは、Arなどの不活性ガスを約0.1~10⁻⁴ Torrの圧力下でプラズマ化したものを加速して、半導体基板表面に衝突させ、その際のイオン衝撃によって食刻を行なう方法である。このスパッタエッチングにおいて、上記CF₄やCCl₄などの反応性ガスを使用すれば、イオン衝撃と化学反応の両者によって食刻が行なわれる。

しかるに、上記CF₄やCCl₄など、炭素とハロゲン元素からなるガスを用いて上記プラズマエッチングやスパッタエッチングを行なうと、フッ素や塩素と分離した炭素が、半導体基板の表面や反応容器の壁面に付着し、表面の粗悪や汚染を生ずることが多い。

とくに、半導体基板表面に付着した炭素は、高精度な微細加工を妨げ、半導体装置製造の歩留まりを低下させる原因の一つになっていた。

(発明の目的)

本発明の目的は、上記従来の問題を解決し、炭素による大きな障害を受けることなしに、シリコンもしくはシリコン化合物をドライエッチすることのできる、半導体装置の製造方法を提供することである。

(発明の概要)

上記目的を達成するため、本発明は、含フッ素炭化水素をエッチングガスとして用いて、プラズマエッチングもしくはスパッタエッチングすることにより、シリコンもしくはシリコン化合物を高い精度でエッチングするものである。

従来最も多く用いられたフッ化炭素をエッチングガスとして使用すると、上記のように炭素による障害が生ずる。

すなわち、フッ素イオン F^- やフッ素ラジカル F^\cdot はシリコンのエッチングに主として有効で、

CF_4 の形のイオンやラジカルは酸化シリコンなどのエッチングに有効であるといわれている。

しかし、 F と分離されて生じた C は、シリコンやその化合物をエッチングする化学的作用は有しておらず、反応性スパッタエッチングなどの際に、被エッチング物の表面に打込まれて汚染の原因となる。

このような C によって表面が汚染されたシリコン基板上に配線を形成すると、両者間の接触抵抗が大きくなり、良好なコンタクトを得ることは難しくなる。

上記汚染層は、フッ酸を含むエッチ液を用いても除去することはできない。上記反応性スパッタエッチングなどを行なった後、⁺酸イオンを照射して、 Si を SiO_2 とし、フッ酸処理を用いてこの酸化物層を除去することにより、汚染層を除去することは可能であるが、酸イオンの照射という煩雑な工程が必要であるばかりでなく、照射された酸イオンによって、基板などが損傷される、という問題が生ずる。

- 3 -

これに対し、 CH_3F などのように、含フッ素炭化水素をエッチングガスとして使用すると、上記フッ化炭素の場合と同様に C イオンやラジカルは生ずるが、 H イオンやラジカルも同時に生成される。

C と H のラジカルやイオンが共存するプラズマ中においては、両者はプラズマのエネルギーによって容易に重合し、たとえば $-(CH_3)-$ という形の化合物となって、被エッチング物や反応容器壁面上に付着したり、あるいは外部に排出されたりする。

上記 $-(CH_3)-$ のような重合物は、中性化して安定であるため、被エッチング物に打込まれることはほとんどなく、単に表面に吸着されるのみである。

このような表面上に付着した $-(CH_3)-$ は、レジスト膜を除去するために行なわれる酸液プラズマによる酸化によって容易に除去できるため、 CF_4 などフッ化炭素を用いた際に生ずる上記問題が生ずる恐れは極めて少ない。

- 4 -

上記含フッ素炭化水素は、 C の数が少ないほど、 C による障害が少なく、好ましい。

とくに、 C の数が2以下の含フッ素炭化水素であるフッ化メチル(CH_3F)、フルオロホルム(CHF_3)、トリフルオロエチレン

($C_2H_2F_4$)、フッ化ビニル(C_2H_3F)、フッ化エチル(C_2H_5F)、もしくはジフルオルエタン($C_2H_4F_2$)をエッチングガスとして使用すると、 O_2 の添加や酸イオンの照射を行なわなくても、極めて好ましい結果が得られる。

すなわち、シリコン基板上に形成された SiO_2 膜の所望部分を、ホトレジスト膜をマスクに用い、ドライエッチングによって選択エッチする際に、 CF_4 などをエッチングガスとして用いると、 SiO_2 膜の除去によって露出されたシリコン基板表面が C によって汚染される。

この汚染された基板上に電極や配線を形成すると、上記のように両者間の接触抵抗が大きくなり、良好なコンタクトが得られなくなる。

上記汚染は、 SiO_2 膜の選択エッチの後に行

- 5 -

- 6 -

特開昭60-143633(3)

第 1 表

エッチングガス	エッチング速度(Å/分)		基板表面の汚染層
	Si	SiO ₂	
CF ₄ F	50	400	10~15分のO ₂ プラズマ処理で除去
CHF ₃	100	500	"
C ₂ H ₂ F ₂	50	500	"
C ₂ H ₂ F	~10	200	約30分のO ₂ プラズマ処理で除去
C ₂ H ₄ F	~10	150	"
C ₂ H ₆ F ₂	~10	150	"

第1表から明らかなように、本発明によれば、エッチングガス中に酸素を添加したり、あるいは、酸素イオンを照射したりすることなしに、酸素プラズマと接触させるだけで、Cによる汚染層が除去される。

従って、SiO₂膜の選択的エッチングに引き続いて行なわれる、酸素プラズマを用いたホトレジスト膜除去の際に、Cによる汚染層も同時に除

なわれる酸素プラズマを用いたホトレジスト膜の除去の際には除去されず、さらに酸素イオンを照射する必要がある。

しかし、Cの数が2以下である上記含フッ素炭化水素をエッチングガスとして使用すると、SiO₂膜の選択エッチ後に引き続いて行なわれる、酸素プラズマによるホトレジスト膜の除去の際に、Cによる汚染層は除去され、酸素イオンの照射を行なわなくても、接触抵抗の小さい良好なコンタクトが形成できる。

CH₂Fなど、Cの数が2以下である上記含フッ素炭化水素をエッチングガスとして用い、ガス圧0.2~0.3 Torr、出力200~300 W/400 KHzという条件で、ホトレジスト膜をマスクにしてSiO₂膜を選択エッチした場合の結果を第1表に示す。なお、装置は、平行平板形反応性スパッタエッチング装置を使用した。

- 7 -

去され、そのまま電極や配線の形成に供することができる。

また、CF₄をエッチングガスとして用いると、Siのエッチング速度がSiO₂のエッチング速度よりはるかに大きいので、SiO₂膜の所望部分を選択的に除去して、コンタクト孔を形成するのは困難である。CF₄にH₂を添加してエッチングを行なえば、SiとSiO₂のエッチング速度比を逆転できるが、H₂は爆発性を有し危険なので、取扱いに特別な注意を必要とする。

しかし、第1表に示したように、本発明によれば、Siに対して十分大きいエッチング速度比でSiO₂をエッチングすることができ、しかも危険なH₂を添加していないので、特別な注意は必要ない。

上記各含フッ素炭化水素は、それぞれ単独で使用してもよく、また、複数種混合して使用してもよいことはいうまでもない。

〔発明の効果〕

上記説明から明らかなように、本発明によれば、

- 9 -

- 8 -

被エッチ物に対するCの障害を防止できる、水素を添加する必要がないので安全性が高く実施が容易である、などの利点を有しており、実用上極めて有用である。

代 理 人 弁 理 士 高 橋 明



- 10 -